

Integrierte Schaltungen und Einzelhalbleiter Gesamtprogramm 1985

6200-179-1D

INTERMETALL semiconductors



Kapazitätsdioden

Si-Tuner-Dioden (gleichlaufsorrt geliefert)

Typ	Gehäuse	Kennwerte bei $T_U = 25^\circ\text{C}$											
		Kapazität		ausnutzbares Kapazitätsverhältnis			Serienwiderstand		Grenzfrequenz für $Q = 1$		Sperrstrom		
		C_{tot} pF	bei U_R V	$\frac{C_{\text{tot}}(\text{xV})}{C_{\text{tot}}(\text{yV})}$	bei xV	yV	r_S Ω	bei f MHz	C_{tot} pF	f_{Q1} GHz	bei U_R V	I_R nA	bei U_R V
BB 221	DO-35	1,8...2,2	28	8,0...9,5	1	28	0,55 (<0,7)	470	9	24	3	<30	30
BB 222	DO-35	1,8...2,5	28	7,3...9,5	1	28	0,8 (<1)	470	9	16	3	<30	30
BB 329	DO-35	2,5...3,2	28	>12	1	28	0,85	330	25	9	3	<30	30
BB 509	23A3**	440...600	1	>15	1	9	–	–	–	–	–	<30	10
BB 521*	DO-35	1,8...2,2	28	8...9,5	1	28	0,55 (<0,7)	470	9	24	3	<30	30
BB 529*	DO-35	2,5...3,2	28	>12	1	28	0,85	330	25	9	3	<30	30
BB 621*	MiniMELF	1,8...2,2	28	8...9,5	1	28	0,55 (<0,7)	470	9	24	3	<30	30
BB 622	MiniMELF	1,8...2,5	28	7,3...9,5	1	28	0,8 (<1)	470	9	16	3	<30	30
BB 629*	MiniMELF	2,5...3,2	28	>12	1	28	0,85	330	25	9	3	<30	30

*Nachfolgetypen von BB221 bzw. BB329 mit verbesserter Linearität der Kennlinie $C = f(U_R)$

**Anschlüsse 1 und 2: Kathode, Anschluß 3: Anode